

2SA817

シリコンPNPエピタキシャル形トランジスタ(PCT方式)
SILICON PNP EPITAXIAL TRANSISTOR (PCT PROCESS)

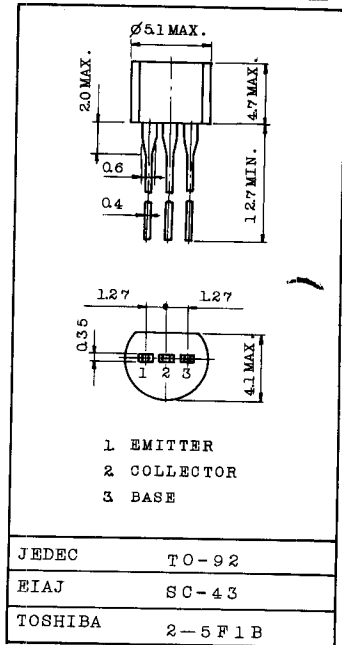
TENTATIVE

- 励振段増幅用
- 電圧増幅用
 - ・ Driver Stage Amplifier Applications
 - ・ Voltage Amplifier Applications
- ・ 2SC1627とコンプリメンタリになります。
- ・ 20~25W用アンプのドライバーに最適です。
- ・ Complementary to 2SC1627
- ・ 20~25W Driver Application

最大定格 MAXIMUM RATINGS (Ta=25℃)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	V _{CB0}	-80	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CE0}	-80	V
エミッタ・ベース間電圧	V _{EB0}	- 5	V
コレクタ電流	I _C	-300	mA
エミッタ電流	I _E	300	mA
コレクタ損失	P _C	600	mW
接合温度	T _j	150	℃
保存温度	T _{stg}	-55~150	℃

Unit in mm



* PCT技術により製造されています。

Produced by Perfect Crystal Device Technology.

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -50V, I_E = 0$	-	-	-100	nA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -5V, I_C = 0$	-	-	-100	nA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = -5mA$	-80	-	-	V
直流電流増幅率	$h_{FE(1)}$ ^(Note)	$V_{CE} = -2V, I_C = -50mA$	70	-	240	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = -2V, I_C = -200mA$	40	-	-	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -200mA, I_B = -20mA$	-	-	-0.4	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE} = -2V, I_C = -5mA$	-0.55	-	-0.8	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = -10V, I_C = -10mA$		100	-	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = -10V, f = 1MHz$	-	14	-	pF

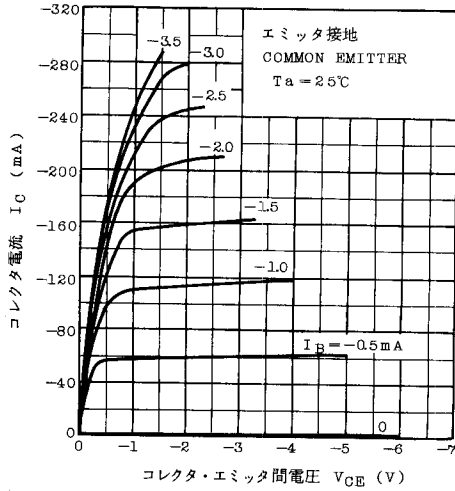
Note ; $h_{FE(1)}$ により下表のように分類し、現品表示してあります。

According to the value of $h_{FE(1)}$, the 2SA817 is classified as follows.

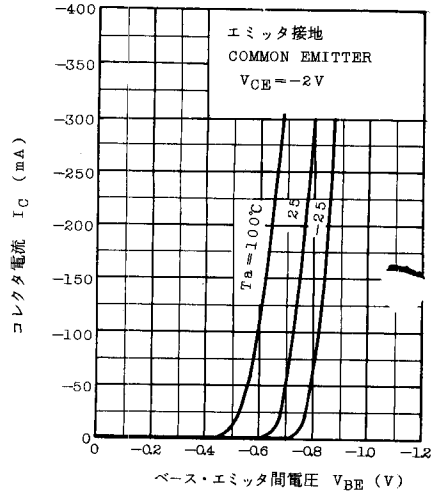
CLASSIFICATION	MIN.	MAX.
2SA817-0	70	140
2SA817-Y	120	240

2SA817

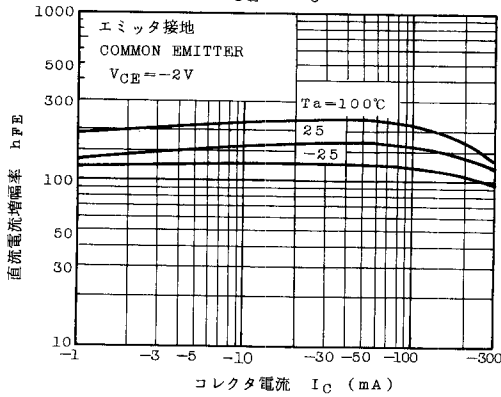
$I_C - V_{CE}$ (LOW VOLTAGE REGION)



$I_C - V_{BE}$



$h_{FE} - I_C$



$V_{CE(sat)} - I_C$

